# BEST AVAILABLE COPY

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-121411

(43)Date of publication of application: 08.05.2001

(51)Int.CI.

B24B 37/04 H01L 21/304

(21)Application number: 11-308105

(71)Applicant: APPLIED MATERIALS INC

(22)Date of filing:

29.10.1999

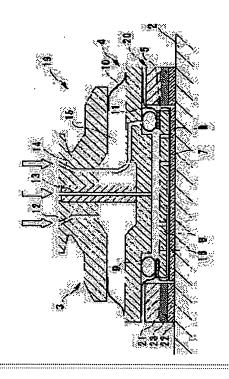
(72)Inventor: SUZUKI KENJI

YASUHARA HAJIME SUNADA YOSHIHIRO

# (54) WAFER POLISHER

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the occurrence of micro-scratches on a surface of a wafer to be polished and to reduce a maintenance manhour. SOLUTION: This wafer polisher is composed of a polishing head 13 arranged around the wafer W and incorporating a retainer ring 20 for restraining radial motion of the wafer W during polishing, an attaching plate 21 with which the retainer ring 20 is fixed to the polishing head 3, and a ceramic abrasion ring 22 mode into contact with a polishing pad 2, and a resin space 23 interposed between the attaching plate 21 and the abrasion ring 22.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-121411 (P2001-121411A)

(43)公開日 平成13年5月8日(2001.5.8)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

B 2 4 B 37/04 HO1L 21/304

622

B 2 4 B 37/04

E 3C058

H01L 21/304

622G

#### 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特顯平11-308105

平成11年10月29日(1999.10.29)

(71)出願人 390040660

アプライド マテリアルズ インコーポレ

APPLIED MATERIALS, I

NCORPORATED

アメリカ合衆国 カリフォルニア州

95054 サンタ クララ パウアーズ ア

ペニュー 3050

(74)代理人 100109726

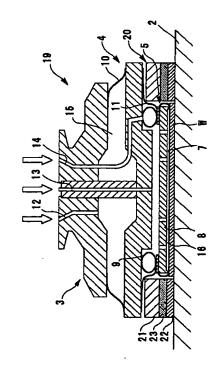
弁理士 園田 吉隆 (外1名)

最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 ウェハー研磨装置

### (57)【要約】

【課題】 ウェハーの被研磨面におけるマイクロスクラ ッチの発生を防止するとともに、保守工数を低減する。 【解決手段】 ウェハーWの周囲に配置され、研磨時に 該ウェハー♥の半径方向の移動を抑制するリテーナリン グ20を備えた研磨ヘッド3を具備し、リテーナリング 20が、研磨ヘッド3に固定される取付板21と、研磨 パッド2に接触させられるセラミック製の摩擦リング2 2と、これら取付板21と摩擦リング22との間に介在 させられる樹脂製のスペーサ23とを具備するウェハー 研磨装置19を提供する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウェハーの周囲に配置され、研磨時に該ウェハーの半径方向の移動を抑制するリテーナリングを備えた研磨へッドを具備し、

前記リテーナリングが、

前記研磨ヘッドに固定される取付板と、

研磨バッドに接触させられるセラミック製の摩擦リング ょ

これら取付板と摩擦リングとの間に介在させられる樹脂 製のスペーサとを具備することを特徴とするウェハー研 10 磨装置。

【請求項2】 前記摩擦リングおよび前記スペーサが、それぞれ円環状に形成されて軸方向に隣接配置され、前記スペーサの内周部に、軸方向に沿って前記摩擦リングの方向に延び、前記摩擦リングの内周面を被覆する被覆部が形成されていることを特徴とする請求項1記載のウェハー研磨装置。

【請求項3】 前記摩擦リングの前記スペーサ側の内周 縁がテーバ状に形成され、前記スペーサの被覆部が、前 記テーバ状の内周縁と相補的な形状に形成されていることを特徴とする請求項2記載のウェハー研磨装置。

【請求項4】 前記スペーサの内径寸法が前記摩擦リングより小さく設定されていることを特徴とする請求項2または請求項3記載のウェハー研磨装置。

【請求項5】 前記スペーサの被覆部が、前記研磨バッドに接触させられる前記摩擦リングの摩擦面よりも一段引っ込んだ位置に先端を有し、該被覆部の先端と前記摩擦リングの摩擦面との段差が、ウェハーの周縁の厚さより小さく設定されていることを特徴とする請求項2から請求項4のいずれかに記載のウェハー研磨装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、ウェハーの化学的機械研磨(CMP)に用いられるウェハー研磨装置に関し、特に、研磨時にウェハーの周囲を取り囲むリテーナリングを備えた研磨ヘッドを具備するウェハー研磨装置において、マイクロスクラッチの低減効果を向上する技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】リテーナリングを備えた研磨ヘッドを具 40 備する従来のウェハー研磨装置には、例えば、図3に示された構造のものがある。このウェハー研磨装置1は、水平回転させられる研磨バッド2と、ウェハーWを吸着して搬送するとともに、該ウェハーWを水平回転させながら、前記研磨パッド2に対して上方から押し付ける研磨ヘッド3とを具備している。

[0003]前記研磨ヘッド3は、図示しない駆動機構によって上下左右に変位させられ、かつ、水平回転させられるキャリアヘッド4と、このキャリアヘッド4に取り付けられ、円盤状のウェハーWを、被研磨面を下向き

にして吸着保持するとともに研磨時にはウェハーWに上方から圧力を印加するウェハー保持部5と、前記キャリアヘッド4に取り付けられ、前記ウェハー保持部5の半径方向外方に配置された円環状のリテーナリング6とを具備している。

【0004】図中、符号7は、ウェハーを吸着または加圧するゴム製の膜状部材からなるメンブレン、符号8は、このメンブレンを支持するメンブレンサポート、符号9はインナーチューブ、符号10,11は、伸縮可能な密封手段、符号12,13,14は空気圧用配管である。

【0005】とのように構成された研磨ヘッド3では、配管12を通した空気圧供給により、第1の加圧室15 が膨張して、リテーナリング6が研磨パッド2に押し付けられるようになっている。また、配管13を通した負圧の供給により、第2の加圧室16が収縮して、ウェハーWがウェハー保持部5に吸着される一方、正圧の供給により、第2の加圧室16が膨張して、ウェハーWが研磨パッド2に押し付けられるようになっている。さら に、配管14への空気圧供給により、インナーチューブ 9が膨張して、ウェハーWを含むウェハー保持部5が押し下げられるようになっている。

【0006】したがって、これらの配管12,13,14に供給する空気圧を調節することにより、前記リテーナリング6は、前記ウェハー保持部5とは独立して上下に駆動できるようになっており、ウェハーWを研磨するときに、上方からの押圧力によって、下端の摩擦面6 aを前記研磨パッド2に押しつけられるようになっている。すなわち、リテーナリング6は、ウェハーWの研磨30時に、研磨パッド2に接触させられることによって、ウェーハWの半径方向外方の空間を閉鎖して、ウェーハWが半径方向外方に飛び出すことを防止するようになっている。

【0007】また、ウェハーWの研磨時に、リテーナリング6にさらに圧力を加えると、研磨バッド2の反動によって、リテーナリング6の内側の研磨バッド2の表面が変動する、いわゆるリバウンド現象が知られている。そして、このリバウンド現象を利用して、リテーナリング6に加える圧力を調節することにより、意識的にウェハーWの研磨状態を変化させることが行われる。すなわち、リテーナリング6は、ウェハーWの研磨状態を調節するための手段としての機能をも有している。

【0008】 これらの機能を有するリテーナリング6は、一般には、図3に示されるように、キャリアヘッド4に固定されるスチール製の取付板17と、この取付板17に図示しないねじまたは接着剤のような任意の取付手段によって固定されたPPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド樹脂)製の摩擦層18とから構成された二層構造を有している。

50 [0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、PPS 樹脂は比較的軟質な材料であるため、リテーナリング6 に印加する圧力によっては、摩擦層18が早期に摩耗す るという不都合がある。そして、摩擦層18が一定重摩 耗した場合には、リテーナリング6を交換しなければな らないが、PPS樹脂からなる摩擦層18を有する場合 には、頻繁に交換作業を行わなければならないという不 都合があった。

【0010】また、摩擦層18が摩耗した場合には、そ の削りかすが、研磨パッド2上に残留して、研磨作業中 にウェハーWの被研磨面にマイクロスクラッチを発生さ せるおそれがある。マイクロスクラッチの発生を防止す るためには、摩擦層18の削りかすを研磨パッド2上か ち除去する作業が必要となり、作業工数を増加させると とになる。

【0011】これらの不都合は、摩擦層18を、より摩 耗の少ない硬質な材料によって構成することにより回避 することができる。しかしながら、摩擦層18の材質 を、PPS樹脂からより硬質な材料に単に置き換えただ けでは、摩擦パッド2への押しつけ圧力が高くなったと きに、摩擦パッド2を早期に損傷させてしまう不都合が 考えられる。

【0012】さらに、摩擦層18が硬質な材料からなる 場合には、該摩擦層18と研磨中のウェハーWとの接触 によって、ウェハーWの外周縁または摩擦層18の内周 縁が損傷するおそれがあり、その破片がウェハー♥の被 研磨面にスクラッチを発生させてしまう不都合も考えら れる。

【0013】本発明は上述した事情に鑑みてなされたも のであって、ウェハーの被研磨面にマイクロスクラッチ 30 を発生させることなく研磨できるウェハー研磨装置を提 供することを目的としている。

#### [0014]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、この発明は、ウェハーの周囲に配置され、研磨時に 該ウェハーの半径方向の移動を抑制するリテーナリング を備えた研磨ヘッドを具備し、前記リテーナリングが、 前記研磨ヘッドに固定される取付板と、研磨パッドに接 触させられるセラミック製の摩擦リングと、これら取付 板と摩擦リングとの間に介在させられる樹脂製のスペー 40 サとを具備するウェハー研磨装置を提案している。

## [0015]

【作用】この発明によれば、取付板と樹脂製スペーサと セラミック製摩擦リングとを順に積層した三層構造のリ テーナリングを備えた研磨ヘッドを有する研磨装置が提 供される。このリテーナリングは、研磨パッドに押しつ けられる摩擦リングがセラミック材料から構成されてい るので、大きな圧力をかけられた状態で研磨パッドに接 触させられても、急激な摩耗を生じることがなく、発生 する削りかすも少ないので、ウェハーの被研磨面におけ 50 出するように形成されている。

るマイクロスクラッチの発生を効果的に抑制することが できる。

#### [0016]

【発明の実施の形態】以下、この発明に係るウェハー研 磨装置の一実施形態について、図1および図2を参照し ながら説明する。本実施形態に係るウェハー研磨装置 1 9は、リテーナリング20の構造において、従来技術に 係る研磨装置1と相違している。なお、以下の説明で は、本実施形態に係るウェハー研磨装置19において、 図3に示した従来のウェハー研磨装置1と構成を共通と する箇所について、同一の符号を用いて、その説明を簡 略化することにする。

【0017】本実施形態に係るウェハー研磨装置19の リテーナリング20は、図1に示されるように、キャリ アヘッド4に固定される取付板21と、研磨パッド2に 接触させられる摩擦リング22と、該摩擦リング22と 前記取付板21との間に介在させられるスペーサ23と からなる三層構造の円環状部材である。

【0018】前記取付板21は、スチール製の円環状部 20 材であり、図示しないねじのような任意の締結具によっ てキャリアヘッド4に固定されるようになっている。前 記スペーサ23は、樹脂、例えば、デルリン(商標)製 の円環状部材であり、例えば、図示しないねじまたは接 着剤あるいはその両方によって、前記取付板21に固定 されている。前記摩擦リング22は、セラミック、例え ば、SiCセラミック製の円環状部材であり、例えば、 図示しないねじおよび接着剤によって、前記スペーサ2 3に固定されている。

【0019】前記摩擦リング22には、図2に示される ように、その上側の内周縁に、テーパ状に形成された面 取部22aが設けられている。この面取部22aは、例 えば、45°の角度で、摩擦リング22の厚さ寸法より 若干小さい長さにわたって形成されている。

【0020】前記スペーサ23には、前記摩擦リング2 2と隣接する下側の内周縁に、前記面取部22aとほぼ 相補的な形状を有する被覆部23 aが設けられている。 すなわち、該被覆部23 aは、前記面取部22 aの縦断 面とほぼ相補的な縦断面形状を有する円環状の突起部分 であり、スペーサ23の軸方向に突出形成されている。 【0021】これにより、前記摩擦リング22と前記ス ペーサ23とを隣接配置して固定すると、摩擦リング2 2の面取部22aにスペーサ23の被覆部23aが隙間 なくと嵌合してこれを埋めるようになっている。これに より、前記被覆部23 aが前記摩擦リング22の内周面 をほぼ被覆することになる。

【0022】とのスペーサ23の内径は、前記摩擦リン グ22の内径よりも若干小さく形成されている。例え ば、本実施形態では、スペーサ23の内周面は、摩擦リ ング22の内周面よりも半径方向内方に約0.4mm突

【0023】さらに、スペーサ23の被覆部23aは、 前記摩擦リング22の厚さよりも若干短く形成されてい る。すなわち、被覆部23aの先端23bは、摩擦リン グ22の摩擦面22bよりも一段引っ込んだ位置まで延 び、研磨パッド2に接触しないようになっている。例え ば、本実施形態では、摩擦リング22の摩擦面22bと 被覆部23aの先端23bとの段差は、約0.3mmに 設定され、ウェハーWの外周縁の厚さ寸法よりも小さく 設定されている。

【0024】このように構成された本実施形態に係るウ 10 ェハー研磨装置により、ウェハー▼を研磨する場合につ いて、以下に説明する。まず、配管13に負圧を供給し て、ウェハーWをウェハー保持部5に吸着させた状態 で、キャリアヘッド4を回転させながら、研磨ヘッド3 を水平回転している摩擦パッド2に接触させる。この際 に、研磨ヘッド3と研磨パッド2との間には研磨材を含 むスラリーを供給する。

【0025】次に、配管12.13.14にそれぞれ空 気圧を供給して、ウェハーWおよびリテーナリング20 を研磨パッド2に押し付けるための加圧力を発生させ る。リテーナリング20に加圧力が印加されると、摩擦 リング22が研磨パッド2に押し付けられることになる が、本実施形態のウェハー研磨装置では、摩擦リング2 2がセラミック材料によって構成されているので、摩耗 が少なく、発生する削りかすが低減される。したがっ て、リテーナリング20の交換周期を長くして、保守に 要する作業工数を低減することができる。

【0026】との場合において、本実施形態のウェハー 研磨装置は、単に摩擦リング22を硬質のセラミック材 料によって構成したのではなく、セラミック製の摩擦リ ング22とスチール製の取付板21との間に樹脂製のス ペーサ23が配置されているので、スペーサ23の緩衝 作用によって摩擦リング22と研磨パッド2との間に過 大な接触圧力が生じることが防止される。このため、硬 質の摩擦リング22を使用しているにも関わらず、研磨 パッド2に与える損傷が少なくて済むという利点があ る。

【0027】また、ウェーハWを回転させながら、回転 している研磨パッド2に接触させると、ウェハーWに、 その半径方向外方に飛び出させる力が作用するが、ウェ 40 ハー保持部5の周囲に配置されたリテーナリング20に よって、ウェハーWの周囲の空間を閉鎖しているので、 ウェハー♥の飛び出しが防止されることになる。この場 合において、ウェハーWはリテーナリング20と機械的 に接触することになるが、本実施形態に係るウェハー研 磨装置のリテーナリング20には、摩擦リング22の内 周面を被覆する被覆部23aがスペーサ23に設けられ ているので、ウェハー♥は樹脂製のスペーサ23の一部 である被覆部23 aのみと接触し、硬質な摩擦リング2

ナリング20とウェハーWとの接触によるウェハーWま たはリテーナリング20の損傷が効果的に防止される 【0028】このように、本実施形態に係る研磨装置に よれば、ウェハー♥の研磨時に、リテーナリング20の 摩耗による削りかすの発生や、ウェハー♥とリテーナリ ング20との接触による破片の発生が防止されるので、 これらの削りかすや破片が研磨パッド上に残留すること による、ウェハー♥の被研磨面におけるマイクロスクラ ッチの発生を効果的に防止することができる。

【0029】さらに、本実施形態においては、摩擦リン グ22の内周縁にテーパ状の面取部22aを形成し、と れを被覆する被覆部23aを、この面取部22aと相補 的な形状に形成したので、スペーサ23から突出するよ うに形成される被覆部23aを十分な機械的強度を有す る形状に形成することができる。その結果、長期にわた る使用、ウェハーWとの頻繁な衝突によっても、被覆部 23aが破断してスペーサ23から脱落することを防止 することができる。

【0030】また、スペーサ23の内径を摩擦リング2 2の内径よりも若干小さく形成したので、リテーナリン 20 グ20と接触するウェハー♥は、より内径側に配されて いるスペーサ23のみと接触し、摩擦リング22と接触 することが確実に防止されることになる。さらに、スペ ーサ23の被覆部23aの先端23bと摩擦リング22 の摩擦面22bとの間に段差を設けたので、研磨時に、 被覆部23 aが研磨パッド2と接触することが防止さ れ、スペーサ23の削りかすの発生を防止することがで きる。

【0031】なお、本実施形態に係るウェハー研磨装置 では、摩擦リング22をセラミックSiCにより構成 し、スペーサ23をデルリン(商標)によって構成した が、これに代えて、他の任意のセラミック材料および樹 脂材料を使用することにしてもよい。また、摩擦リング 22の内周縁にテーパ状の面取部22aを設けたが、そ の角度や長さについては、必要に応じて任意に設定する ことができる。さらに、上記実施形態の説明において は、各部の寸法を具体的に例を挙げて説明したが、本発 明はこれらの寸法に限定されるものではないことは言う までもない。

#### [0032]

【発明の効果】以上、詳述したように、本発明に係る研 磨装置によれば、研磨パッドと接触する位置にセラミッ ク製の摩擦リングを配し、取付板との間に樹脂製のスペ ーサを介在させた3層構造に構成したリテーナリングを 有するので、摩擦リングの摩耗によるリテーナリングの 交換周期を長くして保守に要する工数を低減することが できるとともに、スペーサを緩衝材として機能させて摩 撩リングと研磨パッドとの間に過大な接触圧力が生ずる ことを防止することができる。また、摩擦リングの摩耗 2と接触しないように保護される。したがって、リテー 50 により発生する削りかすが低減されるので、ウェハーの

8

被研磨面におけるマイクロスクラッチの発生を大幅に低減することができるという効果を奏する。

[0033] また、スペーサの内周部に、摩擦リングの内周面を被覆する被覆部を設けたので、研磨時に、ウェハーが、硬質の摩擦リングと接触することを防止することができる。その結果、研磨中のウェハーのチッピングを効果的に防止して、その破片が研磨パッド上に残留することによるマイクロスクラッチの発生を防止することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

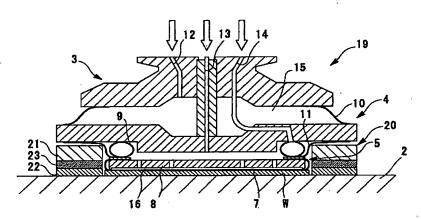
【図1】 本発明に係るウェハー研磨装置の一実施形態を示す概略的な縦断面図である。

【図2】 図1のウェハー研磨装置において使用される リテーナリングを概略的に示す部分的な縦断面図であ る。 \*【図3】 従来のウェハー研磨装置を示す概略的な縦断面図である。

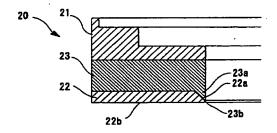
【符号の説明】

- ₩ ウェハー
- 2 研磨パッド
- 3 研磨ヘッド
- 19 ウェハー研磨装置
- 20 リテーナリング
- 21 取付板
- 10 22 摩擦リング
  - 22a 面取部(内周縁)
  - 22b 摩擦面
  - 23 スペーサ
  - 23a 被覆部
  - 23b 先端

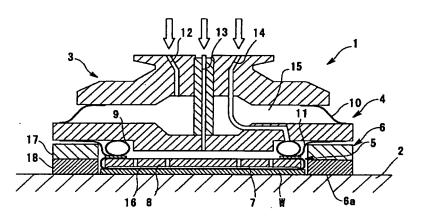
【図1】



【図2】



【図3】



# フロントページの続き

# (72)発明者 鈴木 賢二

千葉県成田市新泉14-3 野毛平工業団地 内 アプライド マテリアルズ ジャパン 株式会社内 (72)発明者 安原 元

千葉県成田市新泉14-3 野毛平工業団地 内 アプライド マテリアルズ ジャパン 株式会社内

(72)発明者 砂田 芳宏

千葉県成田市新泉14-3 野毛平工業団地 内 アプライド マテリアルズ ジャパン 株式会社内

Fターム(参考) 3C058 AA07 AA09 AA12 AB04 CB02 DA17